PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-126967

(43)Date of publication of application: 06.08.1982

(51)Int.CI.

C23C 13/06 C23C 15/00 // H01F 41/14 H01L 21/205 H01L 21/285

(21)Application number: 56-012052

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

29.01.1981

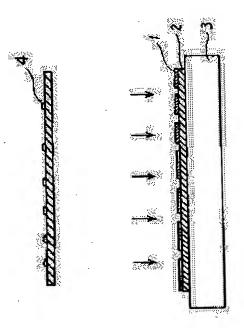
(72)Inventor: KOSHIKAWA YOSHIO

(54) METHOD FOR HOLDING MASK FOR FILM FORMATION

(57)Abstract:

PURPOSE: To carry out the formation of a mask film with good preciseness and a large area by a method wherein a magnet is provided to the back surface of a substrate plate and the ferromagnetic mask is fixedly mounted to the surface of the substrate plate to prevent warpage thereof during the film.

CONSTITUTION: The ferromagnetic mask having a fine pore pattern is attracted to the substrate plate 2 by the magnet 3 provided to the back surface thereof to be fixedly mounted to the surface of said substrate plate 2 and the resulting assemblage is mounted in a vapor deposition apparatus to carry out vapor deposition of a predetermined substance from the side of the mask 1. When the mask 1 is removed in the last processing, a vapor deposition film 4 can be selectively formed only to a part corresponding to the fine pore pattern of the mask 1 and unsharpness of the pattern due to the warpage of the mask is reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57-126967

⑤Int. Cl.³ C 23 C 13/06	識別記号	庁内整理番号 7537—4K	邸公開	昭和57年(19	3 82) 8	月6日
15/00		7537—4K 7537—4K	発明の	数 1		•
#H 01 F 41/14	Į.	7354—5E	審査請	求 未請求		
H 01 L 21/20)5	7739—5 F	,			
21/28	35	7638—5 F			(全	3頁)

図成膜用マスクの保持方法

②特

願 昭56-12052

砂出

願 昭56(1981)1月29日

⑩発 明 者 越川管生

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

切出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明細 有

- 発明の名称 成膜用マスクの保持方法
- 2. 特許請求の範囲
 - (1) マスクを用いて基板の最高に選択的に皮膜を 形成する成膜工程中の成膜用マスク保持方法に かいて、前配基板の裏面から磁力で吸引するこ とによって少くともその1部分が強強性体より 成るマスクを前配基板の表面に固着させること を特徴とする成膜用マスクの保持方法。
 - (2) 機械的保持手段を併用して前記マスクを前記 基板の表面に固着させるようにしたことを特徴 とする特許請求の範囲第(1)項記載の成蹊用マス クの保持方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は蒸着、スパッタ等のマスク成蹊法によって基板上に希望する皮膜パターンを形成する際のマスクの保持方法に係り、特にマスクを成譲すべき基板等の裏面に設置した磁石あるいは電磁石等の磁力を用いて固定し、基板全面にわたって密

着させる方法に関する。

従来の成腹用マスク保持方法としては機械的保持方法があるが、ホルダーとマスクの熱膨緩係数や温度の差による応力。および/またはマスクに付着した膜による応力などによってマスクが反り、それによってパターン程度がおちるのを防ぐためにマスクの根厚を増したり、マスクの面積を小さくしたりしなければならないという欠点がある。即ち、可復を小さくすればコスト/パーフォーマンス比が悪くなる。

本発明の目的は成膜中にマスクが反ることが無く、したがって精度のよいかつ大面積のマスク成 源を可能にする方法を提供することにある。

本発明の成膜用マスクの保持方法は基板の裏面から磁力で吸引することによって、少くともその1部分が強強性体より成るマスクを基板の表面に固着させることを特徴としている。 すなわち、本発明は強強性体が磁石に強くひかれるという特徴を利用し、強強性体でできたマスクあるいは強強

性体と非磁性体を組みあわせたマスクを成膜すべき基板等に全面にわたって密着させ、マスクと基板等の間のギャップを小さいまま保持するように したものである。

次に契施例により本発明の成膜用マスクの保持方法につき説明する。第1図は本発明の方法の1 契施例を説明するための図である。細孔パターン を有する強磁性マスク1は基板2の裏面にある協 石3によって吸引され、基板表面に固着される(第 1図(A))。 しかる後これらは蒸煙を関内に装填され、所定の物質がマスク側から蒸煙される(第1 図(B))。 最后にマスクを除去すれば、マスク上の 蒸馏物はマスクと共に除去され、基板上にはマス クの細孔部分にのみ蒸産物(皮膜)4か週択的に 形成される。

マスク1と悲板2の位置決めのためには、第2 図に示す様なガイトピン5を磁石製質に複数個設ければ良い。

本発明の第2の実施例として、 做嫁的保持手段 を用いた場合を第3図に示す。この場合、マスク

- 3 -

るための図である。

1 … 労協性マスク、2 … 基板、3 … 磁石、4 … 皮膜、5 … 枠o

代理人 弁理士 松 岡 宏四郎

特別昭57-126967 (2)

1 は根似的保持手段である枠 6 と電磁石 3 とによって基板 2 の 裂面により 堅固に保持される。 特に枠 6 によって 機械的 衝散等による マスク の位置すれる防止する ことができる。

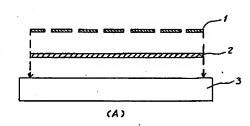
本 発明の方法は 磁性材料。 金 機材料。 半導体材料等種々の材料の 成膜に 適用でき、 更に 具体的には 薄膜 田気 ヘッド の製造等に 有用である。

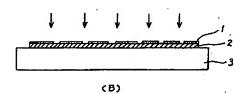
以上のよりに本発明によれば、マスクを結板全面に密着させることができるのでマスクの反りによるパターンのほけをへらす効果がある。さらに、 複級的な保持方法だけでは固定。密溜の困難な행 腹のマスクも保持できるので高精度のパターンを 形成できるという効果がある。

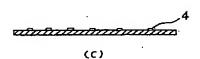
尚、本発明の方法は上記実施例に限定されず、マスクとしては非母性体と強母性体から成るもの、例えば非母性板上に強母性膜を被増したものでも良く、また母石は遊根から離して設置してもよく、母石としては永久母石。 電母石のいずれでも良い。

4. 図面の簡単な説明

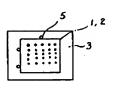
第1図ないし第3回は本発明の実施例を説明す



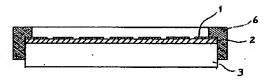




第 1 図



第 2 図



第 3 図